MAKE ECG 153

USE 2SB507

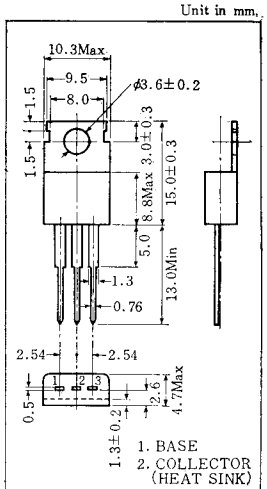
シリコンPNPエピタキシャルメサ形トランジスタ
SILICON PNP EPITAXIAL MESA TRANSISTOR (TENTATIVE)

2SA489

○電力増幅用
○ Power Amplifier Applications

- h_{FE} の直線性がよい.
- 飽和電圧が低い：$V_{CE(sat)}=-0.7V$(Typ.)
- コレクタ損失が大きい：$P_C=30W$ ($T_C=25°C$)
- 2SC789 とコンプリメンタリで出力20～25Wクラスの Hi-Fi OTL アンプに最適です.
- 20～25W Output Application with 2SC789 as a Complement

Unit in mm.



JEDEC TO-220AB
EIAJ SC-46
TOSHIBA 2-10

アクセサリはAC75を適用
MOUNTING KIT NO. AC75

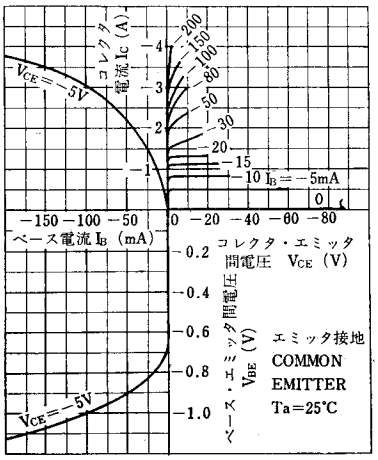
最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	−70	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	−60	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	−5	V
コレクタ電流	I_C	−4	A
エミッタ電流	I_E	4	A
コレクタ損失 ($T_C=25°C$)	P_C	30	W
接合温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	−55～150	°C

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C)

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-50V$, $I_E=0$	—	—	−30	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5V$, $I_C=0$	—	—	−100	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=-100mA$, $I_B=0$	−60	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=-10mA$, $I_C=0$	−5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE}=-5V$, $I_C=-0.5A$	40	—	240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-5V$, $I_C=-3A$	15	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-3A$, $I_B=-0.3A$	—	−0.7	−1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V_{BE}	$V_{CE}=-5V$, $I_C=-2.5A$	—	−0.9	−1.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CE}=-5V$, $I_E=0.5A$	3	—	—	MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10V$, $I_E=0$, f=1MHz	—	230	—	pF

Note ; $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し, 現品表示してあります.
According to the value of $h_{FE(1)}$, the 2SA489 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA489—R	40	80
2SA489—O	70	140
2SA489—Y	120	240

STATIC CHARACTERISTICS